

- Пи 2-19с** *Р. К. Яфаров, В. Я. Шаньгин*  
Поверхностный фазовый переход в системе углерод – кремний
- Пи 2-20с** *Е. А. Андреев, П. А. Буцуийкин, Е. В. Демидов, Д. Н. Лобанов, А. В. Новиков, Е. В. Скороходов, П. А. Юнин*  
Рост и оптоэлектронные свойства слоёв InN, выращенных методом МПЭ ПА при различных соотношениях потоков III и V групп
- Пи 2-21с** *Е. А. Андреев, О. Б. Гусев, А. Н. Яблонский, А. В. Еришов, Д. А. Грачев, И. Н. Ясевич, З. Ф. Красильник*  
Спектры возбуждения и кинетика люминесценции экситонов, автолокализованных на состояниях поверхностных димеров в нанокристаллах кремния
- Пи 2-22с** *А. Ю. Клоков, А. И. Шарков, Д. Ф. Аминов, В. А. Цветков, Р. А. Хмельницкий*  
Зондирование когерентными фонами заглубленных в алмаз графитизированных слоев, созданных имплантацией ионов углерода
- Пи 2-23с** *Д. Е. Свиридов, В. И. Козловский*  
Сканирующая микроскопия сопротивления растекания с подсветкой: искажения на топографических изображениях
- Пи 2-24с** *С. А. Денисов, А. В. Нежданов, В. Ю. Чалков, В. Н. Трушин, Д. О. Филатов, Ю. Н. Бузынин, В. Г. Шенгуров*  
Гетерозитаксиальный рост Ge на Si(100) методом горячей проволоки
- Пи 2-25с** *Г. Б. Галиев, Е. А. Климов, А. Н. Ключков, Д. В. Лаврухин, С. С. Пушкарёв*  
Структурные и фотолуминесцентные исследования низкотемпературного GaAs на подложках GaAs (100) и (111)A
- Пи 2-26с** *Н. А. Байдакова, А. И. Бобров, В. М. Данильцев, М. Н. Дроздов, А. В. Новиков, Д. А. Павлов, М. В. Шалеев, П. А. Юнин, Д. В. Юрасов*  
Формирование на Si(001) релаксированных слоев Ge высокого кристаллического качества

- Пи 2-27с** *П. Н. Брушков, А. В. Бакланов, Н. Д. Прасолов, А. А. Гуткин, Н. А. Калужский, С. Г. Кошкин*  
Эффект локальной трибоэлектризации поверхности эпитаксиального слоя n-GaAs с помощью зонда атомно-силового микроскопа
- Пи 2-28с** *В. К. Егоров, Е. В. Егоров, С. А. Кукушкин*  
Исследования монокристаллических и эпитаксиальных структур силицида углерода
- Пи 2-29с** *А. П. Демоченко, С. А. Денисов, М. И. Дроздов, А. И. Машин, В. А. Гава, А. Д. Буланов, А. В. Нежданов, А. А. Ежевский, М. В. Стетихова, В. Ю. Чалков, В. Н. Трушин, Д. В. Шенгуров, В. Г. Шенгуров, N. V. Abrosimov, H. Rietz*  
Эпитаксиально выращенные моноизотопные слои Si, Ge и Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>; получение и свойства
- Пи 2-30с** *Е. А. Емельянов, А. В. Васев, Б. Р. Семягин, А. П. Василенко, А. А. Команов, А. К. Гутаковский, М. А. Пулято, В. В. Преображенский*  
МЛЭ твёрдых растворов InAsSb на GaAs (001): влияние молекулярной формы As на состав и кристаллическое совершенство эпитаксиальных слоев
- Пи 2-31с** *А. И. Никифоров, В. А. Тимофеев, А. Р. Туктамышев, В. И. Машин, С. А. Тийс, М. Ю. Есин*  
Влияние Sn на морфологию поверхности при росте соединений Si-Ge-Sn на Si(100) методом МЛЭ
- Пи 2-32с** *Л. С. Паршина, О. А. Новодворский, О. Д. Храмова, В. А. Михалевский, А. В. Шорохова, И. А. Петухов, Ф. Н. Путилин, М. Н. Румянцев*  
Импульсное лазерное осаждение прозрачных проводящих слоев SnO<sub>2</sub>:Sb на гибких легкоплавких органических подложках для оптоэлектронных применений
- Пи 2-33с** *Д. В. Дмитриев, А. М. Галинский, А. И. Торопов, А. С. Кожухов, Д. В. Щеголов, А. П. Василенко, К. С. Журавлёв*  
МЛЭ слоёв In<sub>0.52</sub>Al<sub>0.48</sub>As на подложке InP для высокочастотных фотодиодов